



Transistor de RF / FET Canal N / 8 W / 520 MHz / 7.5 Vcc / SMD

SKU: MRF-1517-T1 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$914.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor de RF tipo N de alta potencia diseñado para aplicaciones comerciales e industriales de banda ancha en frecuencias de hasta 520 MHz. La alta ganancia y el rendimiento de banda ancha de este dispositivo lo hacen ideal para amplificadores de fuente común de gran señal en equipos FM portátiles de 7.5 voltios. Ofrece potencia de salida de 8 watts con ganancia de potencia de 11 dB y eficiencia del 55%. Caracterizado con parámetros de impedancia de señal grande equivalente en serie, presenta excelente estabilidad térmica y capacidad para manejar condiciones de VSWR 20:1. Su encapsulado de plástico SMD permite montaje superficial optimizado para producción en serie.

Características principales

- Transistor RF tipo N de alta potencia
- Frecuencia máxima de operación: 520 MHz
- Potencia de salida: 8 W
- Voltaje de operación: 7.5 Vcc
- Ganancia de potencia: 11 dB
- Eficiencia en RF: 55%
- Diseño SMD para montaje superficial
- Excelente estabilidad térmica
- Manejo de VSWR 20:1 @ 9.5 Vcc, 520 MHz, 2 dB de sobremodulación

Caracterizado con parámetros de impedancia de señal grande equivalente en serie

Especificaciones técnicas

Tipos de dispositivos

Transistor RF FET Canal N

Frecuencia máxima

520 MHz

Potencia de salida

8 W

Voltaje de operación

7.5 Vcc

Ganancia de potencia

11 dB

Eficiencia RF

55%

Tipo de encapsulado

SMD (montaje superficial)

Manejo VSWR

20:1 @ 9.5 Vcc, 520 MHz, 2 dB sobremodulación

Caracterización

Parámetros de impedancia de señal grande equivalente en serie

Estabilidad

Excelente estabilidad térmica

Aplicaciones típicas

Amplificadores de fuente común de gran señal

Equipos FM portátiles de 7.5 V

Sistemas de comunicación en frecuencias hasta 520 MHz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta ganancia de potencia de 11 dB
Característica 2	Eficiencia del 55% en operación RF
Característica 3	Operación estable hasta 520 MHz
Característica 4	Excelente estabilidad térmica integrada
Característica 5	Soporta VSWR 20:1 en condiciones extremas
Característica 6	Encapsulado SMD para montaje superficial